Silicon Fast Recovery Diode

V_{RRM} = 50 V - 400 V

I_F = 12 A

Features

- High Surge Capability
- Types up to 400 V V_{RRM}

DO-4 Package

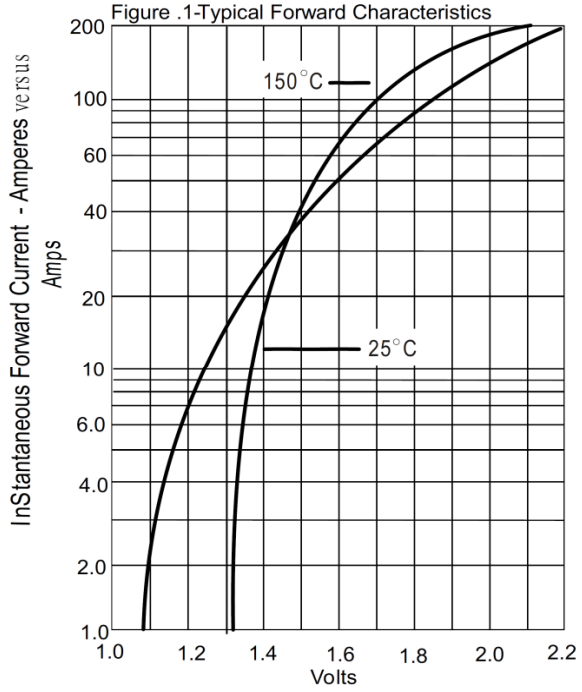
Maximum ratings, at T_j = 25 °C, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	1N3889 (R)	1N3890 (R)	1N3891 (R)	1N3892 (R)	1N3893 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		50	100	200	300	400	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		35	70	140	280	420	V
DC blocking voltage	V_{DC}		50	100	200	400	600	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 100$ °C	12	12	12	12	12	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	T_C = 25 °C, t_p = 8.3 ms	90	90	90	90	90	A
Operating temperature	T_j		-65 to 150	-65 to 150	-65 to 150	-65 to 150	-65 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-65 to 175	-65 to 175	-65 to 175	-65 to 175	-65 to 175	°C

Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

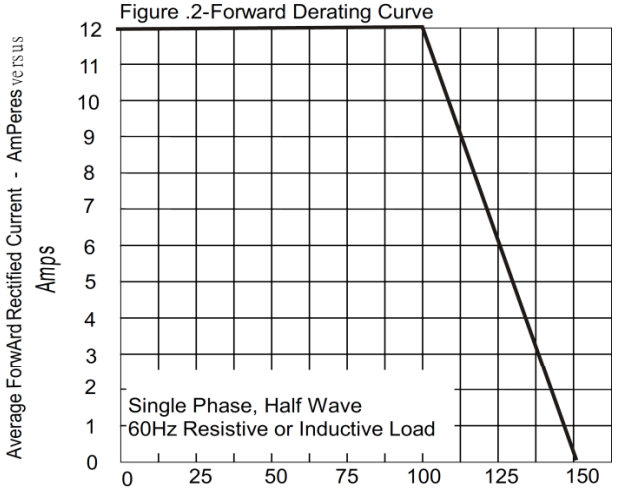
Parameter	Symbol	Conditions	1N3889 (R)	1N3890 (R)	1N3891 (R)	1N3892 (R)	1N3893 (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	I_F = 12 A, T_j = 25 °C	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	V
Reverse current	I_R	V_R = 50 V, T_j = 25 °C	25	25	25	25	25	µA
		V_R = 50 V, T_j = 150 °C	6	6	6	6	6	mA
Recovery Time								
Maximum reverse recovery time	T_{RR}	I_F=0.5 A, I_R=1.0 A, I_{RR}= 0.25 A	200	200	200	200	200	nS
Thermal characteristics								
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	°C/W

Figure .1-Typical Forward Characteristics



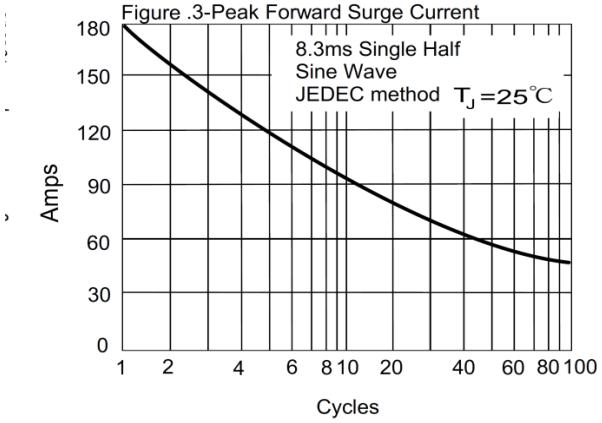
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure .2-Forward Derating Curve



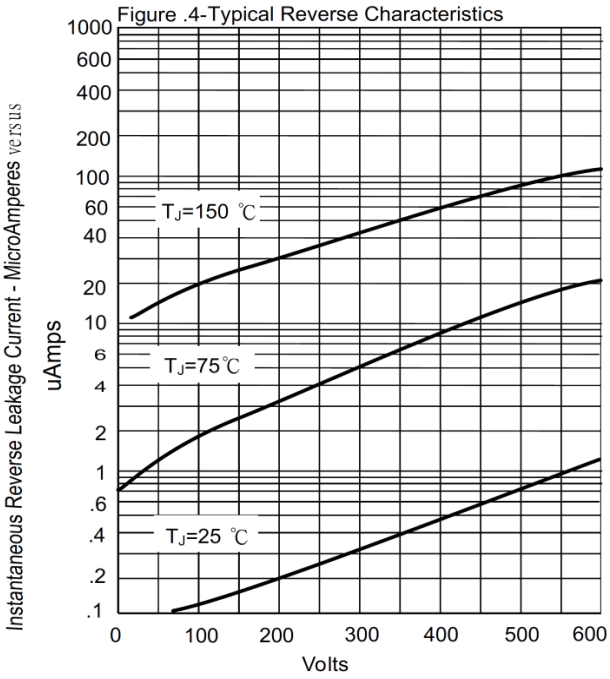
Case Temperature - ℃

Figure .3-Peak Forward Surge Current



Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

Figure .4-Typical Reverse Characteristics



Reverse Voltage - Volts

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9